生 産 研 究 547

研究速報

Cr³⁺からの蛍光を利用した走査型高速微小部 応力測定装置の設計と試作

A new high-speed scanning local stress measurement system using Cr³⁺ fluorescence

垣 澤 英 樹^{*}・川 添 敏^{*}・香 川 豊^{**} Hideki KAKISAWA, Satoshi KAWAZOE and Yutaka KAGAWA

1. 緒 言

多結晶体セラミックスの内部には、構成する結晶粒の異 方性や複合化による第2相の存在によって導入される熱応 力、材料作製時や加工時に導入される残留応力など様々な 内部応力が存在している。例えば、工業的に多く用いられ ている Al₂O₃は、結晶方位によって異なる熱膨張係数と弾 性率を持っており、材料内部には熱膨張係数の異方性によ って~400 MPa 程度の大きさを持った熱応力分布が生じ るといわれている。Al₂O₃中のミクロな熱応力とマクロな 力学特性は密接な関係を持っている。従って、材料中の局 所的応力分布を結晶粒オーダーのディメンジョンで測定 し、ミクロな不均一性が材料の特性に及ぼす影響を評価す ることは非常に重要である。

微小部分の応力測定方法として, ラマン分光法, 蛍光分 光法などの光学的手法は光学顕微系と組み合わせることに より優れた空間分解能を得ることが可能である.また, 試 料の準備が簡単であることや, 測定温度や雰囲気の制限が 少ないことなど多くの利点を持っている.特に, 顕微蛍光 分光法はスペクトル強度が強く検出が容易である.

この原理を利用した従来の測定方法は,一度の測定で一 点の測定を行うものがほとんどで,クラック近傍の2次元 応力分布を測定しようとすると長い時間をかけて膨大な数 の点測定を繰り返さなければならない.この方法では測定 の効率が悪いうえに,クラック進展中に変化する動的な応 力分布を測定することは不可能である.しかし,平面上を 連続的に走査して二元応力測定を可能にした装置の開発例 は非常に少なく,結晶粒径オーダーの空間分解能で,かつ 動的な挙動を追尾できる速さで2次元応力分布の測定を行 った報告はない.

ここでは、顕微蛍光分光法を利用して材料中の結晶粒オ

*東京大学生産技術研究所 **東京大学生産技術研究所 材料界面マイクロ工学研究センター ーダーの二次元応力分布を短時間で測定出来る装置の開発 を行い、基本性能を調べた結果を報告する.

2. 測 定 原 理

本研究で用いた装置では Al_2O_3 中に含まれる Cr^{3+} からの 蛍光のピークシフトを利用して Al_2O_3 に働く応力を測定す ることを前提とした. Al_2O_3 に彼長の短いレーザーを照射 すると Al^{3+} の置換原子として存在している Cr^{3+} の 3 d 電子 軌道の 3 つの電子が励起され、それらが基底状態に戻る過 程で 2 つのピークを持った蛍光スペクトル (ピーク波 数: R 1=14400 cm⁻¹, R 2=14430 cm⁻¹)を発する. Al_2O_3 に 力が働く(ひずみが生じる)と、構成イオン間の距離が変 化し電子状態や振動状態の遷移エネルギーが変化するた め、この蛍光のピーク波数が変化する. 蛍光のピーク波数 のシフト量 (Δv) と Al_2O_3 に働いている応力 (σ_{ij})の関係 は

で表される¹⁾⁻⁵⁾.ここで、 \prod_{ij} はピエゾスペクトロスコピック定数である.この関係を用いて、 Cr^{3+} のピーク波数 (R1=14400 cm⁻¹, R2=14430 cm⁻¹)シフトから Al_2O_3 に働いている応力を計算することが可能である.

多結晶 Al_2O_3 では、多数の結晶粒を含む領域からのピー クシフトの平均値 $\Delta \overline{v}$ から測定領域の平均応力($\overline{\sigma}$)を得る ことができる. $\Delta \overline{v} \ge \overline{\sigma}$ の間は

の関係がある¹⁾⁻⁵⁾.ここで、 Π_{11} 、 Π_{33} はそれぞれ Al₂O₃の a軸および c軸に沿った応力によるシフトに対応した定数 であり、(2 Π_{11} + Π_{33})=7.62 GPa⁻¹cm⁻¹である⁶⁾.今回の測定 では、レーザー光の密度関数の半値幅と結晶粒径はほぼ等

しいディメンジョンであり,この式を適用するのは適切で ないが,結晶粒単位の領域内での有意なピークシフトを検 出することが可能かどうかを判断する目安としてこの式を 用いてシフト量を応力に換算した.

2. 装置の概要

設計・試作した装置は、レーザー光を2次元で試料上を 走査させ、試料から発生した蛍光を分光し得られたスペク トルを2次元 CCD 素子で検出するものである.2次元 CCD 素子を用いることによって一水平方向走査ラインの蛍光の 検出を一度に行うことが可能になる.検出された蛍光スペ クトルから決定されたピークシフトを用いて試料上の各点 の応力を計算し、応力マッピング図を表示することができ る.

レーザー光源には最大出力2W(457.9–514.5 nm 全波長 同時発信時)の Ar^+ レーザー発振器(日本電気,GLS 3280) を用い,横方向単一モード(TEM₀₀),ビーム径1.2 mm (1/e²強度),ビーム拡がり角0.5 mrad,波長514.5 nm のレ ーザー光(最大出力0.8 W)を発振させる.このレーザー 光を共焦点レーザー走査顕微鏡ヘッド(レーザーテック, 1 LM 21)内に導入した.レーザー発振器からヘッドまで の光路は約600 mm である.ヘッド内部の音響光学偏向 (AO)素子で図1のように連続的に水平方向(x方向)の 走査を行い,さらに水平方向に走査するレーザー光をガル バノミラー(振動ミラー)で垂直方向(y方向)に移動さ せる(最大525行)ことによって,試料上でレーザー光の 2次元走査を行う.レーザー走査顕微鏡の走査速度は水平 方向が15.73 kHz,垂直方向が最高60 Hz である^{*}.

*本装置では垂直方向の移動速さは CCD コントローラから出さ れる信号によって制御される



図2はレーザー光および蛍光の装置内の光路を示したも のである. 試料上を走査するレーザー光は,水平方向の走 査速度が水平方向の走査速度よりもはるかに速いため,測 定中には水平方向に伸びた帯状の光がガルバノミラーの角 度の変化によって垂直方向に移動していくように見える. この帯状の光が照射された部分からの蛍光を再びガルバノ ミラーを経由して分光系へ導出する.したがって,レーザ ー走査顕微鏡ヘッドから導出される蛍光像は水平方向の一 走査ライン分の帯状の像であり,垂直方向の移動によって 異なる垂直方向位置のライン像が逐次得られることにな る.

レーザー顕微鏡から導出された一水平方向走査ライン分 の帯状の光を本装置のために特別に設計した小型分光器で 分光し,分光した像を CCD素子(Princeton Instrument, Inc., LN/CCD-576-E/1)(縦 384×横 576 ピクセル)で検出 する.このとき、2次元 CCD素子を用いることによって 一水平方向走査ラインの蛍光スペクトルを一度に測定する ことが可能である.CCD素子は横方向が波数軸を,縦方 向が水平方向の位置を表すように設置されている.従って, 水平方向の空間分解能は CCD素子の縦方向のピクセル数 となる.得られた CCD イメージ(スペクトルデータ)を コンピュータに取り込む.一水平方向走査ラインの取り込 みの完了と同時に TTL 信号をレーザー顕微鏡ヘッドに送 りガルバノミラーを作動させ,水平方向走査ラインを垂直 方向に一行分移動させる.この操作を繰り返し,二次元の



速 報 究

蛍光分光を行うことができる.

コンピュータに取り込まれたスペクトルデータは特別に 開発したピークシフト測定用ソフトによって解析する.こ のソフトではピークの初期値及び半値幅を与え、ローレン シィアン、ガウシアンまたは両方を任意の割合で足し合わ せたものでスペクトル曲線のフィッティングを行う.材料 力が働いていないときの基準ピーク波数を与え、各位置ご とのシフト量を計算する.ソフトの解析から得られたシフ ト量を用いて応力を計算し、応力マッピング図を作成す る.

3. 装置の性能

3.1 走査範囲および走査時間

水平方向に伸びた帯状の光を垂直方向に移動させるガル バノミラーの動作確認を行った.一水平方向走査ラインの 取り込みの完了と同時に TTL 信号がレーザー顕微鏡ヘッ ドに発信されガルバノミラーが作動し,水平方向走査ライ ンを垂直方向に一行分移動させることができた.この動作 を連続して行うことにより、2次元走査を行うことができ た.このとき、測定可能な視野は対物レンズを変えること により、約270×200 µm(水平方向×垂直方向)から約 5.4×4.0 mm まで変化させられる.

3.2 スペクトル分解能

Cr₂O₂を0.5 wt % 含む Al₂O₃焼結体を研磨し、約0.3 mW の Ar⁺ レーザー光(波長514.5 nm) で研磨面の走査を一次 元(水平方向)で行った、図3に発生した蛍光のスペクト ルを2次元 CCD 素子で検出した例を示す. CCD 素子の縦 方向のピクセル数が分光前の水平方向スキャン幅を表して おり、縦方向のピクセルを使用してx方向の分解能を得る



ことが可能であることが確認された。得られた2次元 CCD イメージの横方向の断面(A点から発生した蛍光のスペク トルを表す)からわかるように、横方向のピクセルを用い て Cr³⁺のR1, R2の2つのピークを識別することができ た.

3.3 空間分解能

対物レンズによって集光された励起光を対象物に照射し たとき、検出される蛍光は焦点および焦点のごく近傍から 発生する蛍光を積算したものになる、すなわち、検出され る蛍光の強度は、例えばx方向では

である.ここで,g.(u) は与えられた測定系での蛍光強度 のx方向の密度関数を焦点からの距離uの関数として表し たものである.装置の空間分解能を評価するため, x, y方 向の密度関数の測定を行った.x方向に関しては,エッジ が直角になっている厚さ≈1mmのAl₂O3板を走査光に対し て図4(a)のように置き、走査線上の各点での蛍光ピーク 強度 L(x) を得た. 走査は 10-20 回行い,得られた L(x) の平均値 I.(x)を微分することにより x 方向の密度関数

 $g_x(x) = \frac{d\tilde{I}_x(x)}{dx}$

を得た.y方向に関しては、Al₂O₃板を走査光に対して図 5(a)のように置き、Al₂O₃板のない領域から走査を開始し 走査光が完全に Al₂O₃3板の存在する領域に入るまで走査 を行い、各走査線での蛍光ピーク強度の平均値を $\overline{I}_{i}(y)$ と した.x方向と同様にこれを微分することによりy方向の 密度関数 g_v(y) を得た.

図 4(b) に測定された $I_x(x)$ および得られた $g_x(x)$ を示 す. Al_oO_o板が存在する場所では蛍光の強度は一定である が、Al₂O₃板の縁の近傍で強度は急激に減少し始め、端部 から約15 µmの間にほぼゼロになっている.g,(x) は最大 値をとる位置を中心にほぼ対称な形をもっており、ガウス 分布でよく近似できた.このときの半値幅は約5µmであ った. 一方, y方向では, 図5(b) のように Al₂O₃板の縁 の近傍での L(y)の減少は x 方向のほぼ 1/2の約10 µmの 間に完了しており,x方向と比較して空間分解能が優れて いることがわかった.g_v(y)の形状は,最大強度をとる位 置を中心にほぼ対称で中心部近傍の密度が高い台形型であ った.

作製した装置の空間分解能は対物レンズの開口数. CCD 素子の解像度、スキャン幅によって決まる、スキャン機構 および検出系の性能から空間分解能を考えると 50 倍の対

550 52巻11号(2000.11)



図4 x方向の分解能測定例



> 物レンズを用いた場合,水平方向270 µm の範囲をCCD素 子の縦方向の384ピクセルで検出することになる.また, 垂直方向に関しては200 µm の範囲を525行の走査を行う ことになる.したがって,結晶粒径オーダー(~µm)の 分解能は十分に得られるはずであり,測定された空間分解 能は,装置の性能を最大限に引き出しているとはいえない. 原因としてはレーザー光のビームを試料上で集光していな いことやレーザー光のビームサイズが大き過ぎることなど が考えられる.光学系を調整すればµm オーダーまで向上 させることは十分可能であると考えられるが,現状で得ら れた分解能は10 µm オーダーであった.

5. 結 論

 Al_2O_3 中から発生する Cr^{3+} 蛍光のピークシフトを用いた 走査型顕微蛍光分光法を利用して材料中の結晶粒オーダー の二次元応力分布を短時間で測定出来る装置の開発を行っ た.本装置の空間分解能は,密度関数の反値幅 $\approx 10 \, \mu m$ 以 下が達成されたが,スキャン機構および検出系の性能から 考えると装置の性能を最大限に引き出しているとはいえ ず,今後の検討が必要である.なお,本装置により Al_2O_3 多結晶では $10 \, \mu m$ オーダーの応力場を測定することが可 能であることが明らかになった.

(2000年10月18日受理)

参考文献

- R. H. Reinhold and J. W. Ager, "Quantitative Sress Mapping in Alumina Composites by Optical Fluorescence Imaging," Acta Mater. 44, 625-641 (1996).
- A. L. Schawlow, "Fine Structure and Properties of Chromium Fluorescence in Alumina and Magunesium Oxide" in Advances in Quantum Electronics ed. by J.R. Singer, pp. 50-64, Columbia University Press, New York (1961).
- L. Grabner, "Spectroscopic Technique for the Measurement of Residual Stress in Sintered," J. Appl. Phys.49, 580-583 (1978).
- Q. MA and D. R. Clarke, "Stress Measurement in Single Crystal and Polycrystalline Ceramics Using Their Optical Fluorescence," J. Am. Ceram. Soc. 76, 1433-1440 (1993).
- Q. MA and D. R. Clarke, "Measurement of Residual Stresses in Sapphire Fiber Composites Using Optical Fluorescence," Acta Metall. Mater. 41, 1817-1823 (1993).
- R. G. Munro, G. J. Piermarini, S. Block, and W. B. Holtzapfel, "Model Line-Shape Analysis for the Ruby R Lines Used for Pressure Measurement," J. Appl. Phys., 57, 165-169 (1985).